Влияние магнитного фазового перехода на перенос заряда в слоистых полупроводниковых ферромагнетиках TICrS₂, TICrSe₂

© Р.Г. Велиев, Р.З. Садыхов, Э.М. Керимова[¶], Ю.Г. Асадов, А.И. Джаббаров

Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Az-1143 Баку, Азербайджан

(Получена 26 января 2009 г. Принята к печати 4 февраля 2009 г.)

Твердотельной реакцией синтезированы кристаллы TICrS₂, TICrSe₂. Рентгенографическим анализом выявлено, что соединения TICrS₂ и TICrSe₂ кристаллизуются в гексагональной сингонии соответственно с параметрами кристаллической решетки a = 3.538 Å, c = 21.962 Å, $c/a \approx 6.207$, z = 3, рентгеновской плотностью $\rho_x = 6.705$ г/см³ и a = 3.6999 Å, c = 22.6901 Å, $c/a \approx 6.133$, z = 3, рентгеновской плотностью $\rho_x = 6.209$ г/см³. В интервале температур 77–400 К проведены магнитные и электрические исследования, которые показали, что TICrS₂, TICrSe₂ являются полупроводниковыми ферромагнетиками. Достаточно большое отклонение значения экспериментального эффективного магнитного момента TICrS₂ ($3.26 \mu_B$) и TICrSe₂ ($3.05 \mu_B$) от теоретического ($3.85 \mu_B$) объясняется наличием двумерного магнитного упорядочения в парамагнитной области сильно слоистых ферромагнетиков TICrS₂, TICrSe₂. Обнаружено влияние магнитного фазового перехода на перенос заряда в TICrS₂, TICrSe₂.

PACS: 75.30 Gw, 75.50 Dd, 75.50.Pp

1. Введение

Исследование влияния магнитного фазового перехода на перенос заряда в магнитоупорядоченных кристаллах является одной из центральных задач в физике магнитных явлений. Проблема стала более актуальной в связи с появлением сильно анизотропных (слоистых, цепочечных) магнетиков, в которых при исследовании их физических свойств обнаруживаются особенности, вытекающие из модели Изинга–Гейзенберга [1].

Эти особенности, прежде всего такие как явное отклонение от λ -типа аномалии на температурной зависимости теплоемкости (в адиабатическом калориметре) [2–4], могут наблюдаться в магнетиках, кристаллическая структура которых низкосимметрична, при этом кристаллохимическая формула таких магнетиков должна содержать, как минимум, 3 атома.

Низкосимметричность кристаллической структуры магнетиков типа TlMeX₂ (где Me = 3d-металл, X = S, Se, Te) [5–9] предопределяет зависимость их магнитных и электрических свойств от основных кристаллографических направлений, в некоторых случаях вплоть до возникновения низкоразмерного эффекта, когда спиновая система (магнитная структура) магнетика в парамагнитной области, в определенном температурном интервале, находится в квазидвумерном или квазиодномерном магнитном упорядочении (модель Изинга–Гейзенберга) [1–4,10].

В работе [8] были синтезированы соединения TlCrS₂, TlCrSe₂ и проведены рентгено-, нейтронографические и магнитные исследования, которые показали, что оба соединения имеют кристаллическую решетку ромбоэдрической сингонии и являются ферромагнетиками. Следует отметить, что проведенные в этой работе рентгеновские исследования предполагают низкоразмерность магнитной структуры слоистых ферромагнетиков TlCrS₂ и TlCrSe₂, хотя некоторые магнитные характеристики (например, намагниченность) не согласуются с этим предположением. Так, магнитный момент ферромагнетика TlCrS₂ оказался равным $2.4 \,\mu_{\rm B} \,(\mu_{\rm B}$ — магнетон Бора), что близко к магнитному моменту свободного иона хрома (Cr³⁺). Это обстоятельство противоречит приведенной в работе [8] модели слоистой кристаллической структуры TlCrS₂. Кроме того, в [8] электрические свойства TlCrS₂, TlCrSe₂ не были изучены. Соответственно не был рассмотрен такой фундаментальный вопрос: влияет или нет магнитный фазовый переход на перенос заряда в ферромагнетиках TlCrS₂, TlCrSe₂.

Учитывая вышеизложенное, мы синтезировали кристаллы $TlCrS_2$, $TlCrSe_2$ по отличной от использованной в [8] технологии и провели их рентгенографические, магнитные и электрические исследования.

2. Синтез и рентгенографический анализ

Составы TlCrS₂ и TlCrS₂ были синтезированы из навесок химических элементов, взятых в стехиометрическом соотношении, в электрической печи, в эвакуированных до остаточного давления $\sim 10^{-3}$ Па кварцевых ампулах. Предварительно хром (Cr) в шаровой мельнице приводился в порошкообразное состояние. Синтез проводился методом наклонной печи при температуре ~ 1050 К и длился 72 ч. Затем продукт твердотельной реакции тщательно измельчался и синтез повторялся. После этого полученные составы приводились в порошкообразное состояние, спрессовывались и в эвакуированных кварцевых ампулах подвергались гомогенизирующему отжигу при температуре ~ 600 К в течение 480 ч.

[¶] E-mail: ekerimova@physics.ab.az

0.8

0.6

0.4

Рентгенографический анализ образцов TlCrS2 и TlCrSe₂, специально подготовленных после отжига, проводился при комнатной температуре $(\sim 300\,{\rm K})$ на дифрактометре ДРОН-3М (Си K_{α} -излучение, Ni-фильтр, длина волны $\lambda = 1.5418$ Å, режим 35 кВ, 10 мА). Угловое разрешение съемки составляло ~ 0.01°. Использовался режим непрерывного сканирования. Углы дифракции определены по максимуму интенсивности. В экспериментах ошибка определения углов отражений не превышала $\Delta \theta = \pm 0.02^{\circ}$.

В интервале углов $10 < 2\theta < 70^{\circ}$ были зафиксированы дифракционные отражения от образцов TlCrS2 и TlCrSe₂, которые, в отличие от данных [8], индицируются как соответствующие гексагональной сингонии со следующими параметрами кристаллической решетки: a = 3.538 Å, c = 21.962 Å, $c/a \approx 6.207$, z = 3, pentгеновская плотность $\rho_x = 6.705 \,\text{г/см}^3$ и $a = 3.6999 \,\text{\AA}$, c = 22.6901 Å, $c/a \approx 6.133$, z = 3, рентгеновская плотность $\rho_x = 6.209 \, \text{г/см}^3$ соответственно.

3. Приготовление образцов и методики исследования

Намагниченность (σ) соединений TlCrS₂, TlCrSe₂ измерялась на маятниковом магнитометре Доменикалли, а парамагнитная восприимчивость (χ) — методом Фарадея на магнитоэлектрических весах. Образцы для измерений имели цилиндрическую форму высотой $h \approx 3$ мм, диаметром $d \approx 2.5$ мм.

Электропроводность (σ_e) и коэффициент термоэдс (S) TlCrS₂, TlCrSe₂ исследовались четырехзондовым компенсационным методом. Образцы для измерений имели форму параллелепипеда с размерами $7.15 \times 4.57 \times 2.53$ мм (TlCrS₂) или $8.95 \times 5.25 \times 2.78$ мм (TlCrSe₂). Омические контакты создавали путем электролитического осаждения меди на торцы образцов. Исследования проводились в температурном интервале $T = 77 - 400 \, \text{K}$ в квазистатическом режиме, при этом скорость изменения температуры составляла 0.2 К/мин. Во время измерений образцы находились внутри азотного криостата и в качестве датчика температуры применялась медь-константановая термопара, спай которой стационарно закреплялся на кристаллодержателе вблизи образца. Опорный спай термопары стабилизировался при температуре тающего льда.

4. Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены температурные зависимости удельной намагниченности $\sigma(T)$ TlCrS₂, TlCrSe₂ в магнитном поле 10 кЭ. Из рисунка видно, что значения намагниченности как TlCrS2, так и TlCrSe2, в отличие от данных работы [8], малы и с понижением температуры при $T \approx 100 \,\mathrm{K}$ для обоих соединений наблюдается ее



Рис. 1. Температурные зависимости удельной намагниченности TlCrS₂ (a) и TlCrSe₂ (b).



Рис. 2. Зависимости удельной намагниченности $TlCrS_2(a)$, TlCrSe₂ (b) от магнитного поля при 77 К.

резкий рост. Отсутствие насыщения зависимости намагниченности от магнитного поля Н при 77 К (рис. 2) свидетельствует о близости температуры измерения к области магнитного превращения. Действительно, обработка экспериментальных результатов в области магнитного превращения по методу термодинамических коэффициентов [11] показала, что температура Кюри $T_{\rm C} \approx 90 \,\mathrm{K}$ в TlCrS₂ и $T_{\rm C} \approx 105 \,\mathrm{K}$ в TlCrSe₂.



Рис. 3. Температурные зависимости обратной парамагнитной восприимчивости TlCrS₂ (a), TlCrSe₂ (b).

Температурные зависимости обратной парамагнитной восприимчивости $\chi^{-1}(T)$ TlCrS₂, TlCrSe₂ (рис. 3) имеют вид, характерный для ферромагнитных материалов. Парамагнитная температура Кюри (Т_р), определенная экстраполяцией зависимости $\chi^{-1}(T)$ на ось температур, равна ~ 115 К для TlCrS₂ и ~ 120 К для TlCrSe₂. Из зависимостии $\chi^{-1}(T)$ (рис. 3) рассчитан эффективный магнитный момент (μ_{eff}), который оказался равным 3.26 μ_{B} для TlCrS₂ и $3.05 \mu_B$ для TlCrSe₂. Теоретическое значение, рассчитанное с учетом чисто спинового значения магнитного момента трехвалентного иона Cr³⁺, равно $3.85\,\mu_{\rm B}$. Отметим, что в работе [8] получены более близкие к теоретическому значению величины экспериментального эффективного магнитного момента — 3.59 µ_В и $3.71 \,\mu_{\rm B}$ соответственно для TlCrS₂ и TlCrSe₂. В нашем случае достаточно большое отклонение $\mu_{\rm eff}$ TlCrS₂ и TlCrSe₂ от теоретического значения, по-видимому, указывает на наличие квазидвумерного магнитного упорядочения в парамагнитной области сильно слоистых ферромагнетиков TlCrS2, TlCrSe2. О низкомерности магнитной структуры TlCrS₂, TlCrSe₂ делается заключение и в работах [3,4] на основании исследования низкотемпературной теплоемкости (в адиабатическом калориметре) этих ферромагнетиков. На температурной зависимости теплоемкости при постоянном давлении $C_p(T)$ TlCrS₂, TlCrSe2 наблюдалась аномалия с явным отклонением от λ-типа.

Отличие магнитных характеристик ($T_{\rm C}$, T_p , $\mu_{\rm eff}$) ферромагнетиков TlCrS₂ и TlCrSe₂, определенных в [8], от

полученных в наших исследованиях связано с различием в технологии синтеза образцов и продолжительности их отжига — 480 ч по нашей технологии и 12 ч в работе [8]. Длительный гомогенизирующий отжиг вносит достаточно существенные коррективы в формирование спиновой системы магнетика со сложным химическим составом.

На рис. 4 представлены температурные зависимости электропроводности, $\sigma_e(T)$, и коэффициента термоэдс, S(T), ферромагнетика TlCrS₂. Как видно из рисунка, температурная зависимость электропроводности TlCrS₂ имеет полупроводниковый ход, а поведение коэффициента термоэдс от температуры свидетельствует о переносе заряда дырками. При этом на зависимости S(T) TlCrS₂ в окрестности температуры $T \approx 340 \,\mathrm{K}$ наблюдается аномалия, которая связана с делокализацией 3d-электронов и участием их в переносе заряда. Отметим, что температура, при которой происходит делокализация 3*d*-электронов (~ 340 K), превышает температуру Кюри $(\sim 90 \,\mathrm{K})$ ферромагнетика TlCrS₂ почти в 4 раза, тем самым косвенно подтверждая наши результаты магнитных исследований, указывающие на наличие двумерного магнитного упорядочения в парамагнитной области сильно слоистого ферромагнетика TlCrS₂.

Температурные зависимости электропроводности, $\sigma_e(T)$, и коэффициента термоэдс, S(T), ферромагнетика TlCrSe₂ приведены на рис. 5. Как видно из рисунка, зависимость $\sigma_e(T)$ в целом имеет полупроводниковый характер. Однако начиная с температуры $T \approx 125$ К на зависимости $\sigma_e(T)$ появляется излом с температурной протяженностью ~ 110 К. Отметим, что парамагнитная температура Кюри TlCrSe₂, определенная нами из магнитных исследований, равна ~ 120 К. По-видимому, излом на зависимости $\sigma_e(T)$ TlCrSe₂ связан с рассеянием носителей заряда на спиновых флуктуационных неоднородностях [12], возникающих при переходе спиновой системы слоистого ферромагнетика TlCrSe₂ из трехмерно-



Рис. 4. Температурные зависимости электропроводности (*a*) и коэффициента термоэдс (*b*) TICrS₂.



Рис. 5. Температурные зависимости электропроводности (*a*) и коэффициента термоэдс (*b*) TICrSe₂.

го магнитного упорядочения в парамагнитное состояние. Зависимость коэффициента термоэдс от температуры TlCrSe₂ свидетельствует о переносе заряда дырками, при этом положительные численные значения S растут в исследованном температурном интервале. Это обстоятельство свидетельствует о том, что 3*d*-электроны остаются локализованными в парамагнитной области слоистого ферромагнетика TlCrSe₂ до температуры, приблизительно в 3.5 раза превышающей $T_{\rm C} \approx 105 \, {\rm K}$, тем самым косвенно подтверждая наши результаты магнитных исследований, указывающие на наличие двумерного магнитного упорядочения в парамагнитной области сильно слоистого ферромагнетика TlCrSe₂. Из рис. 4, 5 видно, что проводимость в TlCrSe₂ значительно выше (на 2 порядка), чем в TlCrS₂. Однако флуктуационная область $(T_p - T_C)$ перехода из магнитоупорядоченного состояния в парамагнитное в TlCrSe₂ уже, чем в TlCrS₂ $(\sim 15 \text{ и } 25 \text{ K } \text{ соответственно})$. Этим и объясняется наличие излома на температурной зависимости электропроводности TlCrSe₂ и отсутствие такового в случае TlCrS₂.

5. Заключение

Таким образом, исследования магнитных и электрических свойств слоистых соединений TlCrS₂, TlCrSe₂ в интервале температур 77–400 К показали, что данные соединения являются ферромагнетиками и обладают полупроводниковым характером электропроводности. Достаточно большое отклонение значения экспериментального эффективного магнитного момента TlCrS₂ ($3.26 \mu_B$) и TlCrSe₂ ($3.05 \mu_B$) от теоретического ($3.85 \mu_B$) объясняется наличием двумерного магнитного упорядочения в парамагнитной области сильно слоистых ферромагнетиков TlCrS₂, TlCrSe₂. Обнаружено влияние магнитного фазового перехода на перенос заряда в TlCrS₂, TlCrSe₂.

Список литературы

- К.С. Александров, Н.В. Федоссева, И.П. Спевакова. Магнитные фазовые переходы в галоидных кристаллах (Новосибирск, Наука, 1983) гл. 2, §4, с. 48.
- [2] M.A. Aldzhanov, N.G. Guseinov, G.D. Sultanov, M.D. Nadzafzade. Phys. Status Solidi B, 159, K107 (1990).
- [3] М.А. Алджанов, А.А. Абдуррагимов, С.Г. Султанова, М.Д. Наджафзаде. ФТТ, 49 (2), 309 (2007).
- [4] M. Aljanov, M. Nadjafzade, Z. Seidov, M. Gasumov. Turkish J. Phys., 20 (9), 1071 (1996).
- [5] A. Kutoglu. Naturwissenchaften B, 61 (3), 125 (1974).
- [6] K. Klepp, H. Boller. Monatsh. Chem. B, 110 (5), 1045 (1979).
- [7] M. Zabel, K. Range. Z. Naturforsch. B, 34 (1), 1 (1979).
- [8] M. Rosenberg, A. Knulle, H. Sabrowsky, C. Platte. J. Phys. Chem. Sol., 43 (2), 87 (1982).
- [9] Г.И. Маковецкий, Е.И. Касинский. Неорг. матер., 20 (10), 1752 (1984).
- [10] Z. Seidov, H. Krug von Nidda, A. Loidl, G. Sultanov, E. Kerimova, A. Panfilov. Phys. Rev. B, 65, 014433 (2001).
- [11] К.П. Белов, А.Н. Горяга. ФММ, 2 (3), 441 (1956).
- [12] Г.В. Лосева, С.Г. Овчинников. В сб. Физика магнитных материалов, под ред. В.А. Игнатченко, Г.А. Петраковского (Новосибирск, Наука, 1983) с. 60.

Редактор Л.В. Шаронова

Influence of magnetic phase transition on charge transport in layered semiconductor ferromagnetics TICrS₂ and TICrSe₂

R.G. Veliyev, R.Z. Sadikhov, E.M. Kerimova, Yu.G. Asadov, A.I. Jabbarov

Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Az-1143 Baku, Republic of Azerbaijan

Abstract TlCrS₂ and TlCrS₂ crystals were synthesized by solid state reaction, examined by *X*-ray, and studied with regard to their magnetic and electric properties. They were found to be of hexagonal syngony with lattice parameters a = 3.538 Å, c = 21.962 Å, $c/a \approx 6.207$, z = 3, roentgen density $\rho_x = 6.705$ g/cm³ and a = 3.6999 Å, c = 22.6901 Å, $c/a \approx 6.133$, z = 3, roentgen density $\rho_x = 6.209$ g/cm³ for TlCrS₂ and TlCrSe₂, respectively. The compounds were found to be semiconductor ferromagnetics over the temperature interval 77–400 K. Rather large deviation of the experimental value of the effective magnetic momentum TlCrS₂ ($3.26 \mu_B$) and TlCrSe₂ ($3.05 \mu_B$) from the theoretical value ($3.85 \mu_B$) was accounted for two-dimensional magnetic ordering in paramagnetic phase. The influence of the magnetic phase transition on charge transport in TlCrS₂ and TlCrSe₂ was revealed.